

关键指标

频率: 19~21GHz
 功率增益: 24dB
 饱和输出功率: 27dBm
 功率附加效率: 34%
 偏置: 漏压 5V, 栅压 -1V
 电压/电流: +5V/215mA
 芯片尺寸: 2.1mm×1.3mm×0.1mm

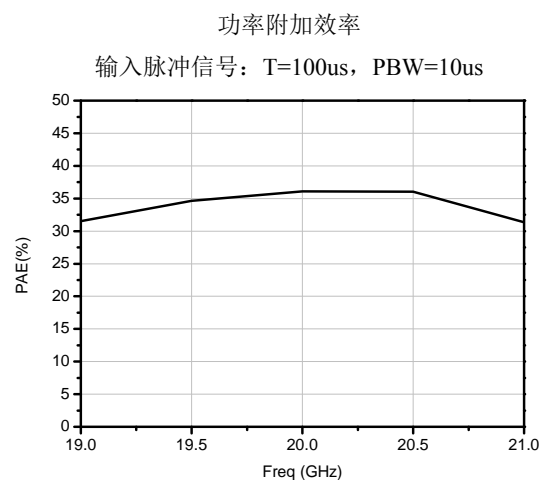
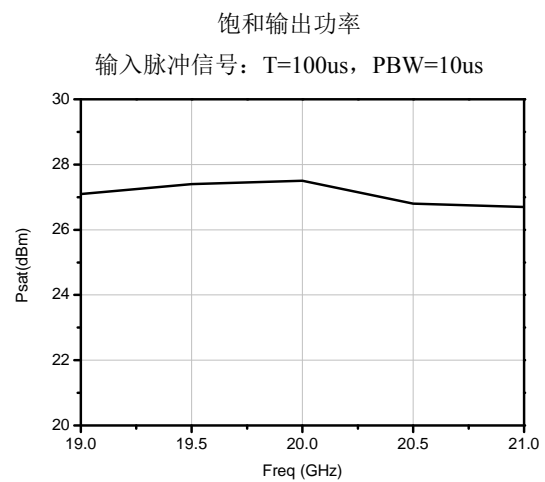
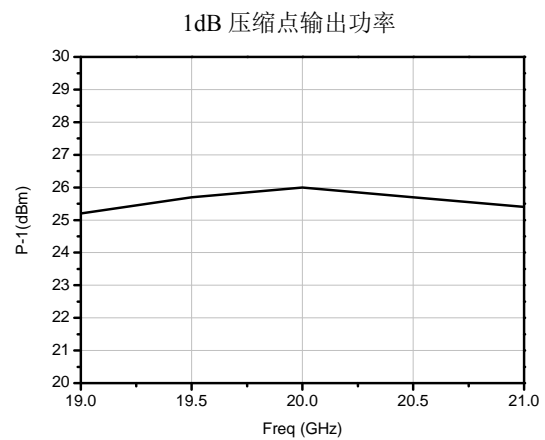
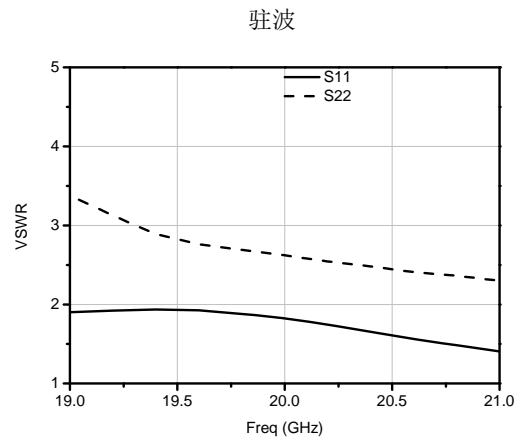
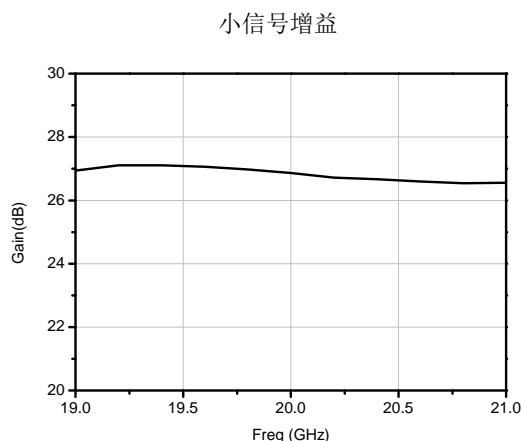
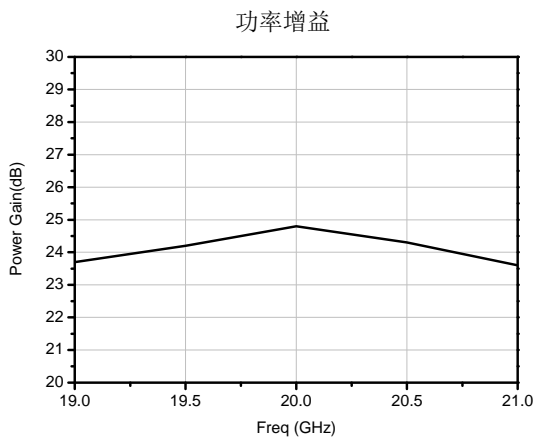
产品简介

HG137FB 是一款 19~21GHz 功率放大器芯片, 小信号增益为 26.5dB, 饱和输出功率为 26.5dBm, 功率附加效率为 34%。

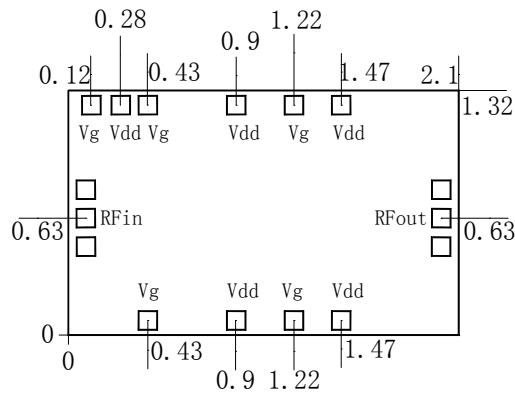
电性能 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{dd}=+5\text{V}$, $V_g=-1\text{V}$, 脉宽 10us, 10% 占空比)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	19~21		
功率增益(dB)	-	24	-
增益平坦度(dB)	-	±0.5	-
输入驻波	-	1.5	-
1dB 压缩点输出功率(dBm)	-	25	-
饱和输出功率(dBm)	-	27	-
功率附加效率	-	34%	-
静态电流 (mA)	-	215	-

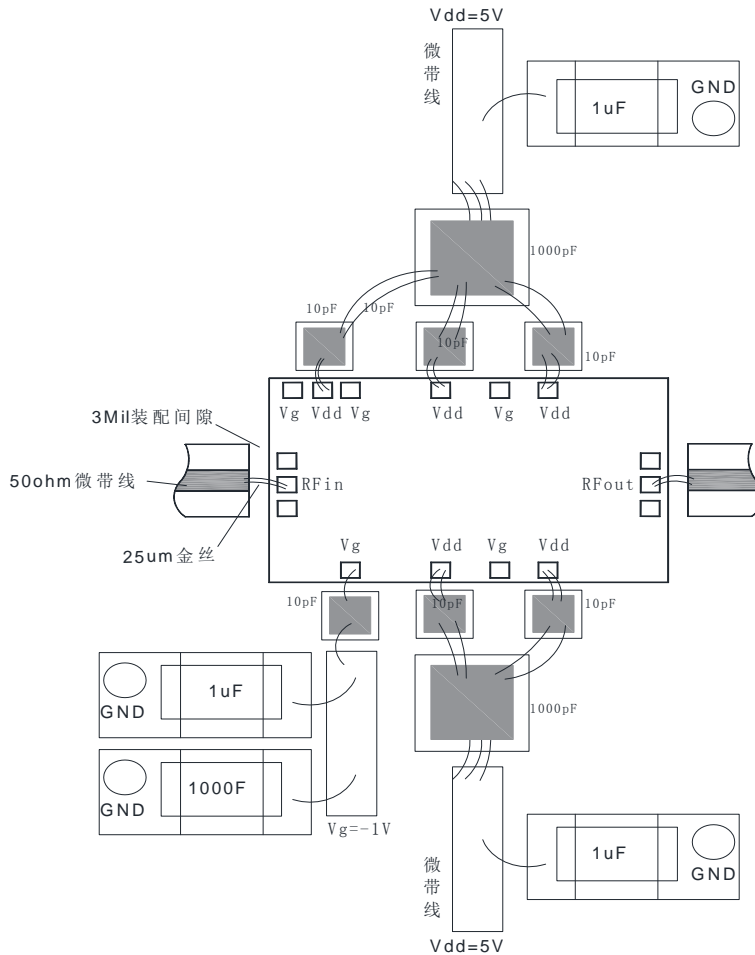
典型测试曲线



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

电源电压	+7V
最大输入功率	+25dBm
工作温度	-55℃~85℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；

2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 50μm 双金带键合，建议金带长度 250~400μm；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。